



#4  
10-4-01  
Moeui

**PATENT APPLICATION**  
**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re application of

Martin KOWATSCH

Attorney Docket Q64035

Appln. No.: 09/832,827

Group Art Unit: 1954

Confirmation No.: 2874

Examiner: Not yet assigned

Filed: April 12, 2001

For: OPTICAL WAVEGUIDE STRUCTURE AND METHOD FOR PRODUCING SUCH A  
WAVEGUIDE STRUCTURE

**SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to  
priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to  
acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

David J. Cushing  
Registration No. 28,703

SUGHRUE, MION, ZINN,  
MACPEAK & SEAS, PLLC  
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 20037-3213  
Telephone: (202) 293-7060  
Facsimile: (202) 293-7860

Enclosures: Germany 10018283.6

Date: July 26, 2001

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 100 18 283.6  
**Anmeldetag:** 13. April 2000  
**Anmelder/Inhaber:** ALCATEL SEL AG, Stuttgart/DE  
**Bezeichnung:** Optische Wellenleiterstruktur und Ver-  
fahren zur Herstellung einer solchen  
Wellenleiterstruktur  
**IPC:** G 02 B 6/30

064035  
1081  
09/832827

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 26. April 2001  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**  
Im Auftrag

Faust

F:\IJBDHF\DHFANM\0138055

Anmelder:  
Alcatel SEL AG  
Lorenzstraße 10  
70435 Stuttgart

0138 055

11.04.2000  
wrz / wrz-neg

**Titel:**     **Optische Wellenleiterstruktur und Verfahren zur  
Herstellung einer solchen Wellenleiterstruktur**

### **Beschreibung**

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische Wellenleiterstruktur, die Leitungen, Kreuzungen, Verzweigungen und/oder Verbindungen umfasst. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Wellenleiterstruktur.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Taktfrequenzen von Mikroprozessoren stetig ansteigen. Inzwischen haben die Taktfrequenzen die 1-GHz-Marke überschritten und in den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Anstieg der Taktfrequenz auf 5 bis 10 GHz zu rechnen.

Der Systemtakt auf Platinen, bspw. einer Systemplatine (sog. Motherboard) eines Rechners, hinkt dem Takt der Mikroprozessoren um Größenordnungen hinterher. Die interne Taktrate der einzelnen Halbleiterbauelemente (sog. Chips) ist zwar bedeutend höher als der Systemtakt auf den Platinen. Die Taktrate wird aber durch die derzeitige Anschluss- und Verbindungstechnik mittels kupferner Leiterbahnen begrenzt. Insbesondere bremsen in den herkömmlichen elektronischen Baugruppen die parasitären Induktivitäten und Kapazitäten der kupfernen Leiterbahnzüge die Geschwindigkeit, mit der die Chips intern die Daten verarbeiten können. Schaltungstechnisch wird es mit kupfernen Leiterbahnen immer schwieriger, das Übersprechen durch die Abstrahlung von hochfrequenten Signalen von den wie Antennen wirkenden Leiterbahnen in den Griff zu bekommen; Dämpfungsverluste verschmieren die rechteckigen Pulsformen und erschweren die Detektion am anderen Ende der Verbindungsleitung. Die Herstellung einer Platine, die mit einer Taktrate von 4 bis 8 GHz noch problemlos arbeitet, wird - wenn überhaupt - erst in mehreren Jahren und nur mit einem sehr großen Aufwand möglich sein.

Eine Möglichkeit zur Erhöhung des Systemtaktes auf den Platinen wäre, die Busbreite zu vergrößern und durch eine höhere Parallelität dieselbe Datenmenge mit einer geringeren Geschwindigkeit auf den einzelnen Leitungen zu übertragen. Das würde jedoch nicht nur zu einer Vervielfachung der Zahl der Leiterbahnen, die auf den Platinen schon jetzt kaum

unterzubringen sind, sondern auch zu einer Erhöhung der Zahl der I/O-Anschlüsse auf den Chips führen. Die Möglichkeiten zur Steigerung der Anschlussdichte, die der Übergang von der rand- zur flächenhaften Kontaktierung bietet, werden jedoch bald an ihre Grenze stoßen. Die Alternative, nämlich die Zahl der Anschlusspins durch eine höhere Datenrate pro Pin wieder zu verringern, lässt sich nur durch eine neue Technologie in der Verbindungstechnik bewerkstelligen.

Vor diesem Hintergrund verfolgen mehrere Firmen und Forschungsinstitute einen Lösungsansatz, der die Datenübertragung über planare Lichtwellenleiter zum Ziel hat, die in konventionelle Leiterplatten integriert werden. Optische Verbindungen sind unempfindlich gegen hochfrequente und elektrostatische Felder; sie überwinden die Probleme der elektrischen Leitungsdämpfung bei hohen Frequenzen, des Übersprechens und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)-Inkompatibilitäten. Zudem sind mit optischen Verbindungen Datenraten von 10 Gbit/s und mehr möglich.

Im Rahmen des vom Bundesforschungsministerium geförderten Vorhabens "Electrical Optical Circuit Board" (EOCB) ist am Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) Berlin ein Verfahren zur Vernetzung von Sender und Empfänger mittels Lichtwellenleiter auf einer optoelektrischen Leiterplatte entwickelt worden, das es erlaubt, eine der Metallisierungsebenen einer konventionellen mehrlagigen

elektrischen Leiterplatte durch eine optische Wellenleiterstruktur zu ersetzen. Dazu werden die Wellenleiter, die einen typischen Querschnitt von 60 Mikrometer  $\cdot$  60 Mikrometer haben, zunächst in einem organischen Folienmaterial mit einem Prägestempel heissgeprägt. Anschließend werden die Gräben mit einem Wellenleitermaterial verfüllt, das einen leicht höheren Brechungsindex als das Folienmaterial aufweist, und dann mit einer zweiten Folie bedeckt. Diese Wellenleiterstruktur kann dann in eine Leiterplatte eingebaut werden. Die Abstände der Lichtleiter zueinander betragen etwa 250 Mikrometer.

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren hergestellten planaren Wellenleiter haben jedoch den Nachteil, dass die optische Dämpfung der Wellenleiter für eine Wellenlänge von 850 nm im Bereich von 0,2 bis 0,5 dB/cm liegt. Für die in der Nachrichtentechnik üblichen Wellenlängen im Bereich von 1300 bis 1550 nm ist die Dämpfung sogar noch höher. Der Grund für diese Dämpfung ist vor allem in der Absorption des Wellenleitermaterials, den Streuverlusten durch Verunreinigungen in dem Wellenleitermaterial sowie der Rauigkeit des Grenzübergangs zwischen Kern und Mantel des Wellenleiters zu suchen. Für die Herstellung einer optoelektrischen Leiterplatte für sog. Backplane-Anwendungen müssen Entfernungen von über 50 cm überbrückt werden. Bei einer Wellenleiterdämpfung von 0,2 dB/cm beträgt dann die Gesamtdämpfung des Wellenleiters über 10 dB zzgl. der Verluste

durch Ankopplung an die optischen Bauelemente. Für Applikationen mit Parallel-Optical-Link (POL) Modulen wäre die verfügbare Leistung damit bereits überschritten.

Ein weiterer Nachteil der planaren Wellenleiter ergibt sich in einer zusätzlichen Dämpfung im Bereich von Kreuzungen.

Kreuzungen sind bei reinen Verteilaufgaben und bei komplexeren Anwendungen notwendig. Die Unterbrechung des

Wellenleitermantels an einer Kreuzung führt zu einer divergenten Strahlführung, wodurch ein Teil des Lichts von einem ersten Wellenleiter in einen den ersten Wellenleiter kreuzenden zweiten Wellenleiter gelangt und dort in den Mantel gelangt, d. h. absorbiert wird. Außerdem wird an den Kanten des Wellenleiters im Bereich einer Kreuzung Licht gestreut, wodurch ein Teil des Lichts aus dem ersten Wellenleiter in den kreuzenden zweiten Wellenleiter gelangt und dort weitergeführt wird. Dies führt zu einem Übersprechen von dem ersten

Wellenleiter auf den zweiten Wellenleiter. Wenn mehrere Wellenleiter einen ersten Wellenleiter kreuzen, addiert sich das Übersprechen und das Signal-/Rauschverhältnis an dem optischen Empfänger am Ende des ersten Wellenleiters wird reduziert.

Aus dem Stand der Technik ist es des weiteren bekannt, eine optische Wellenleiterstruktur aus Glas- und/oder Kunststofffasern mittels einer sog. optischen Multiwire-Technologie herzustellen. Bei dem Multiwire-Verfahren werden

Glas- oder Kunststofffasern auf einem Trägermaterial verlegt. Im Bereich von Kreuzungen der Lichtwellenleiterstruktur verlaufen die Glas- und/oder Kunststofffasern übereinander, so dass Licht aus dem einen Lichtwellenleiter nicht in den überkreuzenden Lichtwellenleiter einstreuen kann. Zudem ist die optische Dämpfung von Glas- und Kunststofffasern sehr gering.

Das optische Multiwire-Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass damit keine Lichtwellenleiterstrukturen mit Verzweigungen und Verbindungen hergestellt werden können.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine optische Wellenleiterstruktur zu schaffen, welche die o.g. Nachteile des Standes der Technik vermeidet und ohne großen Aufwand herzustellen ist. Insbesondere sollte die Wellenleiterstruktur eine geringe optische Dämpfung aufweisen und sowohl Leitungen und Kreuzungen als auch Verzweigungen und Verbindung aufweisen können.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung ausgehend von der optischen Wellenleiterstruktur der eingangs genannten Art vor, dass die Wellenleiterstruktur sowohl planare Wellenleiter, die aus einem in Gräben eingebrachten Wellenleitermaterial bestehen, das einen höheren Brechungsindex als das die Gräben begrenzende Material aufweist, als auch Glas- und/oder Kunststofffasern aufweist.



Die erfindungsgemäßen optischen Wellenleiterstruktur ist also z.T. mittels der planaren Technologie und z.T. mittels der Multiwire-Technologie hergestellt. Die Kombination aus planaren Wellenleitern und Glas- und/oder Kunststofffasern erlaubt es, die Art des Wellenleiters den gegebenen Anforderungen anzupassen. Unterschiedliche Anforderungen an die Wellenleiter ergeben sich insbesondere im Bereich von Leitungen, Kreuzungen, Verzweigungen und Verbindungen der Wellenleiterstruktur.

Die optische Wellenleiterstruktur hat somit in den Bereichen, in denen Glas- und/oder Kunststofffasern eingesetzt werden, eine relativ geringe optische Dämpfung. In den Bereichen der Wellenleiterstruktur, die aus planaren Wellenleitern bestehen, können problemlos Verzweigungen und Verbindungen ausgebildet werden. Das erlaubt es, die Wellenleiterstruktur großflächig und komplex auszubilden, was den Einsatz auf einer Platine, z. B. einem Motherboard oder einem Board für Backplane-Anwendungen, oder in einer elektronischen Baugruppe eines Rechners besonders interessant macht.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Wellenleiterstruktur im Bereich der Verzweigungen und der Verbindungen als planare Wellenleiter und im Bereich der Kreuzungen als Glas- und/oder Kunststofffasern ausgebildet ist, die sich im Bereich der Kreuzungen überkreuzen. Überkreuzen ist in der gesamten

Anmeldung so zu verstehen, dass sich kreuzende Wellenleiter übereinander verlaufen, so dass ein Übersprechen von einem Wellenleiter in einen kreuzenden Wellenleiter vermieden wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Wellenleiterstruktur im Bereich der Leitungen als Glas- und/oder Kunststofffasern ausgebildet ist. Da die Glas- und/oder Kunststofffasern eine relativ kleine Dämpfung aufweisen, können auf diese Weise auch relativ große Entfernung problemlos überwunden werden.

Das Wellenleitermaterial der planaren Wellenleiter ist vorteilhafterweise als ein optisches Polymer ausgebildet. Das Trägermaterial ist vorzugsweise als ein organisches Folienmaterial ausgebildet.

Des weiteren wird vorgeschlagen, eine erfindungsgemäße Wellenleiterstruktur in mindestens eine der Lagen einer mehrlagigen optoelektrischen Leiterplatte einzubringen. Vorteilhafter Weise sind die elektrischen Schichten der optoelektrischen Leiterplatte über optoelektrische Wandler bzw. elektrooptische Wandler mit der optischen Wellenleiterstruktur gekoppelt.

Als eine weitere Lösung der Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird ausgehend von dem Verfahren der eingangs genannten Art vorgeschlagen, dass in ein Trägermaterial dem Verlauf der

Wellenleiterstruktur entsprechende Gräben eingebracht werden, dass in den Gräben Glas- und/oder Kunststofffasern angeordnet werden und dass dann in die Gräben ein Wellenleitermaterial eingebracht wird, wobei das Wellenleitermaterial einen höheren Brechungsindex als das die Gräben begrenzende Material aufweist.

Das die Gräben begrenzende Material besteht üblicherweise aus dem Trägermaterial der optischen Wellenleiterstruktur. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Wandungen der in dem Trägermaterial ausgebildeten Gräben mit einem besonderen Material beschichtet oder ausgekleidet sind, dessen Brechungsindex niedriger ist als der des Wellenleitermaterials.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Glas und/oder Kunststofffasern im Bereich der Kreuzungen derart in den Gräben angeordnet werden, dass sie sich im Bereich der Kreuzungen überkreuzen und dass das Wellenleitermaterial im Bereich der Verzweigungen und Verbindungen in die Gräben eingebracht wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Glas- und/oder Kunststofffasern im Bereich der Leitungen in den Gräben angeordnet werden, bevor das Wellenleitermaterial in die Gräben eingebracht wird.

Gemäß einer anderen bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Trägermaterial als ein organisches Folienmaterial ausgebildet ist, in das die Gräben heissgeprägt werden. Zum Heissprägen wird ein heisser Prägestempel, vorzugsweise ein Metallstempel, eingesetzt, der in die Folie gepresst wird und dort die Gräben erzeugt.

Vorteilhafterweise ist das Wellenleitermaterial als ein optisches Polymer ausgebildet, das in einem fließfähigen Zustand in die Gräben eingebracht und dann mittels Ultraviolett (UV)-Strahlung ausgehärtet wird. Alternativ können die planaren Wellenleiter auch aus Dünnglas bestehen, dessen Seitenwände bspw. durch einen Ätzzvorgang derart strukturiert sind, dass Lichtstrahlen im Inneren des Wellenleiters an den Seitenwänden totalreflektiert werden. Die Glas- und/oder Kunststofffasern werden vorzugsweise in den Gräben verklebt.

Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung, die in der Zeichnung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprüchen oder deren Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulierung bzw.

Darstellung in der Beschreibung bzw. in der Zeichnung. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Platine mit einer erfindungsgemäßen Wellenleiterstruktur gemäß einer bevorzugten Ausführungsform in Draufsicht; und

Figur 2 die Platine aus Figur 1 im Schnitt.

In Figur 1 ist eine Platine 1 mit einer erfindungsgemäßen optischen Wellenleiterstruktur schematisch dargestellt. Die Wellenleiterstruktur ist auf der Platine 1 ausgebildet. Sie umfaßt Leitungen 2, Kreuzungen 3 und Verzweigungen 4 (wenn das Licht den Lichtwellenleiter von links nach rechts durchströmt). Wenn das Licht in der entgegengesetzten Richtung durch den Wellenleiter strömt, ist mit dem Bezugszeichen 4 eine Verbindung bezeichnet.

Im Bereich der Leitungen 2 und der Kreuzungen 3 ist die Lichtwellenleiterstruktur als Glasfaser ausgebildet. Ebenso wäre es denkbar, die Lichtwellenleiterstruktur in diesem Bereich als Kunststofffaser auszubilden. Im Bereich der Verzweigungen/Verbindungen 4 ist die Lichtwellenleiterstruktur dagegen als ein planarer Wellenleiter 6 ausgebildet. Die Glas- und Kunststofffasern 5 haben den Vorteil, dass sie eine geringe optische Dämpfung aufweisen, es im Bereich von Kreuzungen 3 nicht zu einer Streuung oder einem Übersprechen

von Licht aus einem ersten Wellenleiter in einen zweiten kreuzenden Wellenleiter kommt und es im Bereich von Kreuzungen 3 nicht zu einer zusätzlichen Dämpfung kommt. Die planaren Wellenleiter 6 haben ihrerseits den Vorteil, dass sie eine äußerst flexible Gestaltung der Wellenleiterstruktur, insbesondere Verzweigungen und/oder Verbindungen 4, ermöglichen. In Kombination miteinander ergeben die Glasfasern 5 und die planaren Wellenleiter 6 eine optimale Lichtwellenleiterstruktur mit einer geringen Dämpfung, keiner Streuung im Bereich der Kreuzungen 3 und einer besonders hohen Flexibilität bzgl. des Verlaufs der Lichtwellenleiterstruktur, insbesondere kann die Lichtwellenstruktur Verzweigungen und Verbindungen 4 umfassen.

Zur Herstellung der optischen Wellenleiterstruktur werden mittels eines Heissprägeverfahrens Gräben 7 in ein Trägermaterial 8 eingebracht. Alternativ wäre es auch denkbar, die Gräben 7 mit Hilfe eines photolithografischen Verfahrens in das Trägermaterial 8 einzubringen. Die Gräben 7 entsprechen dem Verlauf der zukünftigen Wellenleiterstruktur. Das Trägermaterial 8 ist als eine organische Folie ausgebildet. In die Gräben 7 werden zunächst im Bereich der Leitungen 2 und der Kreuzungen 3 die Glasfasern 5 eingebracht und verklebt. Anschließend werden die noch offenen Bereiche der Gräben 7, also im Bereich der Verzweigungen und/oder Verbindungen 4, mit einem Wellenleitermaterial verfüllt, das einen höheren Brechungsindex als das die Gräben 7 begrenzende Material

aufweist. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel entspricht das die Gräben 7 begrenzende Material dem Trägermaterial 8. Es ist jedoch denkbar, dass die Wandungen der Gräben 7 mit einem zusätzlichen besonderen Material beschichtet oder ausgekleidet werden. Das Wellenleitermaterial ist als ein optisches Polymer ausgebildet, das in einem fließfähigen Zustand in die Gräben 7 eingebracht und mittels Ultraviolett (UV)-Strahlung ausgehärtet wird.

Es wäre auch denkbar, die planaren Wellenleiter 6 aus Dünnglas herzustellen, das eine Stärke von einigen Mikrometern (z. B. 60  $\mu\text{m}$ ) aufweist und dessen Seitenwände durch einen Ätzzvorgang derart strukturiert sind, dass Lichtstrahlen im Inneren des Wellenleiters 6 an den Seitenwänden totalreflektiert werden.

Die Abmessungen der Gräben 7 sind so gewählt, dass im Bereich von Leitungen 2 und Kreuzungen 3 die Glasfasern 5 zumindest teilweise aufgenommen werden können. Im Bereich von Verzweigungen und/oder Verbindungen sind die Gräben 7 den Abmessungen der planaren Wellenleiter 6 entsprechend bemessen ausgebildet.

Die fertige Platine 1 kann Teil einer optoelektrischen Leiterplatte sein. Die optoelektrische Leiterplatte wird hergestellt, indem mindestens eine der Metallisierungsebenen einer mehrlagigen elektrischen Leiterplatte durch eine optische Schicht mit der erfindungsgemäßen optischen

Wellenleiterstruktur ersetzt wird. Die elektrischen Schichten der optoelektrischen Leiterplatte sind über optoelektrische bzw. elektrooptische Wandler mit der Wellenleiterstruktur gekoppelt. Die optoelektrische Leiterplatte ist bpsw. ein Board (z.B. Motherboard) oder eine Baugruppe eines Rechners.

Die erfindungsgemäße Platine 1 eignet sich insbesondere zum Einsatz bei sogenannten Backplane-Anwendungen, wo relativ große Entfernungen überbrückt werden müssen.



### Patentansprüche

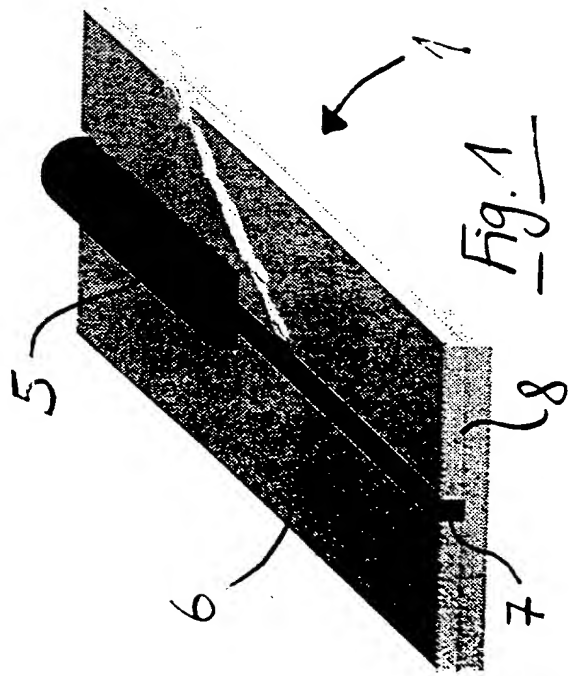
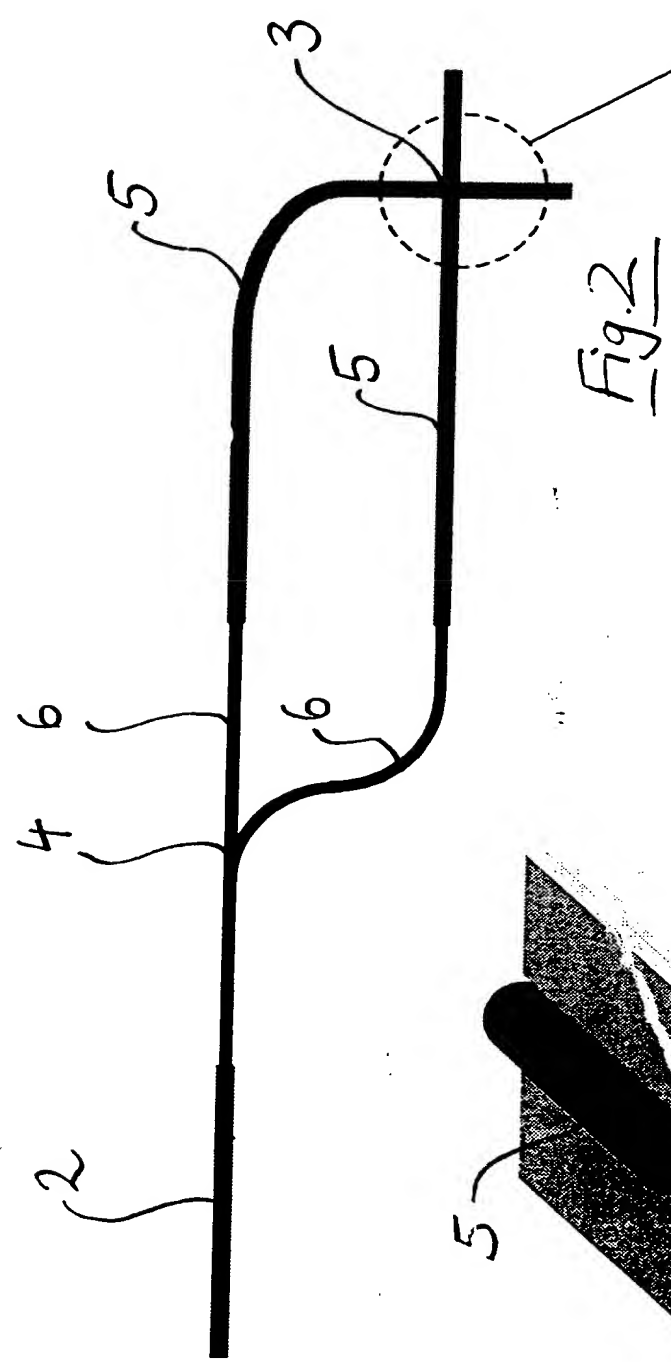
1. Optische Wellenleiterstruktur, die Leitungen (2), Kreuzungen (3), Verzweigungen (4) und/oder Verbindungen (4) umfasst, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Wellenleiterstruktur sowohl planare Wellenleiter (6), die aus einem Wellenleitermaterial bestehen, das in Gräben (7) eingebracht ist, die in einem Trägermaterial (8) ausgebildet sind, wobei das Wellenleitermaterial einen höheren Brechungsindex als das die Gräben (7) begrenzende Material hat, als auch Glas- und/oder Kunststofffasern (5) aufweist.
2. Wellenleiterstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenleiterstruktur im Bereich der Verzweigungen (4) und der Verbindungen (4) als planare Wellenleiter (6) und im Bereich der Kreuzungen (3) als Glas- und/oder Kunststofffasern (5) ausgebildet ist, die sich im Bereich der Kreuzungen (3) überkreuzen. X
3. Wellenleiterstruktur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenleiterstruktur im Bereich der Leitungen (2) als Glas- und/oder Kunststofffasern (5) ausgebildet ist.

4. Wellenleiterstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellenleitermaterial als ein optisches Polymer ausgebildet ist.
5. Wellenleiterstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial (8) als ein organisches Folienmaterial ausgebildet ist.
6. Mehrlagige optoelektrische Leiterplatte, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens einer der Lagen eine Schicht mit einer optischen Wellenleiterstruktur nach einem der vorangegangenen Ansprüche eingebracht ist.
7. Leiterplatte nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen Schichten der Leiterplatte über optoelektrische Wandler bzw. elektrooptische Wandler mit der optischen Wellenleiterstruktur gekoppelt sind.
8. Verfahren zur Herstellung einer optischen Wellenleiterstruktur, die Leitungen (2), Kreuzungen (3), Verzweigungen (4) und/oder Verbindungen (4) umfasst, **dadurch gekennzeichnet**, dass in ein Trägermaterial (8) dem Verlauf der Wellenleiterstruktur entsprechende Gräben (7) eingebracht werden, dass in den Gräben (7) Glas- und/oder Kunststofffasern (5) angeordnet werden und dass in die Gräben (7) dann ein Wellenleitermaterial (6) eingebracht wird, wobei das Wellenleitermaterial (6)

einen höheren Brechungsindex als das die Gräben (7) begrenzende Material aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas- und/oder Kunststofffasern (5) im Bereich der Kreuzungen (3) derart in den Gräben (7) angeordnet werden, dass sie sich im Bereich der Kreuzungen (3) überkreuzen, und dass das Wellenleitermaterial im Bereich der Verzweigungen (4) und Verbindungen (4) in die Gräben (7) eingebracht wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas- und/oder Kunststofffasern (5) im Bereich der Leitungen (2) in den Gräben (7) angeordnet werden, bevor das Wellenleitermaterial (6) in die Gräben (7) eingebracht wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial (8) als ein organisches Folienmaterial ausgebildet ist, in das die Gräben (7) heißgeprägt werden.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellenleitermaterial (6) als ein optisches Polymer ausgebildet ist, das in einem fließfähigen Zustand in die Gräben (7) eingebracht und mittels Ultraviolett (UV)-Strahlung ausgehärtet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas- und/oder Kunststofffasern (5) in den Gräben (7) verklebt werden.



### Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Lichtwellenleiterstruktur, die Leitungen (2), Kreuzungen (3), Verzweigungen (4) und/oder Verbindungen (4) umfasst, und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Lichtwellenleiterstruktur. Um eine Lichtwellenleiterstruktur mit einer möglichst geringen Dämpfung und einem möglichst hohen Grad an Flexibilität bzgl. des Verlaufs der Wellenleiterstruktur zu schaffen, wird vorgeschlagen, dass die Wellenleiterstruktur sowohl planare Wellenleiter (6), die aus einem Wellenleitermaterial bestehen, das in Gräben (7) eingebracht ist, die in einem Trägermaterial (8) ausgebildet sind, wobei das Wellenleitermaterial einen höheren Brechungsindex als das die Gräben (7) begrenzende Material hat, als auch Glas- und/oder Kunststofffasern (5) aufweist. (Figur 1)

